

## ウエハーアニール炉

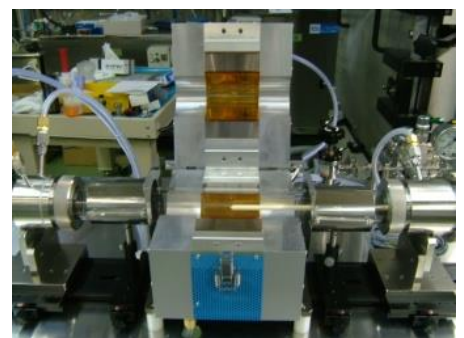
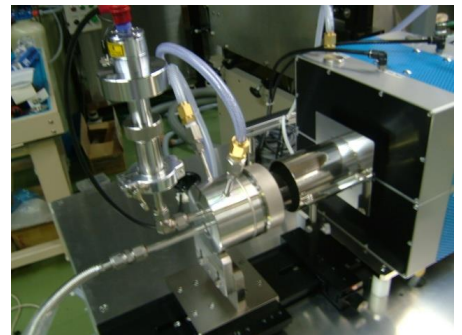
**真空圧力制御、ガスフロー制御、加熱制御が簡単に行えるので  
ウエハーアニール試作に最適です**

**》 特 徴**

- 高速加熱から低速加熱まで幅広い設定範囲
- 試料を固定したままでの多段ステップ加熱
- ガス冷却機構による、急速ガスクェンチコントロール
- 真空中・各種ガスフロー中の加熱が可能
- 装置・架台が一体型のため、正面パネルより  
各種ポンプ・真空計・加熱装置・ガス導入の制御が可能

**》 用 途**

- 各種材料の基礎研究・熱処理シュミレータとして最適
- 半導体・超電導材のCo<sub>2</sub> ガス雰囲気中でのアニール等



## ウエハーアニール炉


 主な仕様

外観	寸法	W1200×D800×H1300
	重量	約200kg
反応容器	反応管	Φ42×600Lmm 石英
	両側フランジ	Oリングシール SUS304
	到達真空度	< E-4Torr以下
試料加熱部	ワークサイズ	< □10mm
	ワークホルダ	グラファイト（任意材料）
	加熱温度	最大使用温度 1700℃（常用1400℃）
	加熱長	100mm
	熱電対	R型熱電対
	制御電源	プログラム設定方式 温度指示精度±1.7℃
真空・排気系	低真空排気系	油回転真空ポンプ 80 l/m（ドライポンプ選択可）
	高真空排気系	ターボ分子ポンプ 50 l/s
真空測定	ガス分離真空容器	大気圧～低真空（ピラニゲージ）
		低真空～中真空（ペニングゲージ）
ガス導入	マスフローコントローラ	3台 < 1 l/m
電源・制御	電源	AC200V 60A
	インタロック	冷却水不足：加熱不可 停電：真空保管及び油回転真空ポンプのリーク


 特注対応

基板サイズ・加熱装置・取付場所に応じ、石英管・取付けフランジの特注に容易に設計対応いたします。

